



三洋半導体
ニュース

No.1134

4272

STK4843

厚膜混成集積回路
30W min 2チャンネル AF パワーアンプ(2電源)用

暫定規格

新製品

- 特長
- ・エミッタフォロワ回路を内蔵し、高級化を図っている。
 - ・ケース温度 125℃ を保証し、放熱板の大幅削減ができる。
 - ・ミュート回路を外付けすることにより、電源 オン、オフ時のショックノイズをなくすることができる。

最大定格/ $T_a=25^\circ\text{C}$

			unit
最大電源電圧	$V_{CC\ max}$	± 43	V
熱抵抗	θ_{j-c}	2.2	$^\circ\text{C}/\text{W}$
接合部温度	T_j	150	$^\circ\text{C}$
動作時 IC 基板温度	T_c	125	$^\circ\text{C}$
保存周囲温度	T_{stg}	$-30 \sim +125$	$^\circ\text{C}$
負荷短絡許容時間	t_b	$V_{CC}=\pm 27.5\text{V}, R_L=8\Omega$ $P_O=30\text{W}, f=50\text{Hz}$	2 sec

推奨動作条件/ $T_a=25^\circ\text{C}$

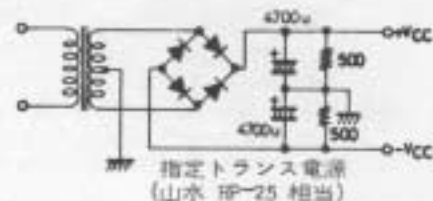
			unit
推奨電源電圧	V_{CC}	± 27.5	V
負荷抵抗	R_L	8	Ω

動作特性/ $T_a=25^\circ\text{C}, V_{CC}=\pm 27.5\text{V}, R_L=8\Omega, R_g=600\Omega, V_G=40\text{dB}$, 指定測定回路 (応用回路例に準ずる) において、

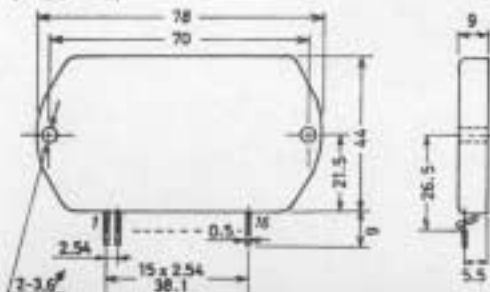
			min	typ	max	unit
無信号電流	I_{000}	$V_{CC}=\pm 34\text{V}$	35	70	120	mA
出力電力	$P_O(1)$	THD=0.02%, $f=20\text{Hz} \sim 20\text{kHz}$	30			W
	$P_O(2)$	$V_{CC}=\pm 23\text{V}$, THD=0.08%, $R_L=4\Omega, f=1\text{kHz}$ 30				W
全高調波ひずみ率	THD	$P_O=1\text{W}, f=20\text{Hz} \sim 20\text{kHz}$			0.02	%
周波数特性	f_L, f_H	$P_O=1\text{W}$		10~100k		Hz
入力抵抗	r_i	$P_O=1\text{W}$		32k		Ω
出力雑音電圧	V_{NO}	$V_{CC}=\pm 34\text{V}$			1.2	mV rms
出力中点電圧	V_N	$V_{CC}=\pm 34\text{V}$	-70		+70	mV

(注) ・検査時の電源には、指定のないかぎり定電圧電源を使用する。

- ・負荷短絡許容時間 および 出力雑音電圧の測定は、右図の指定トランス電源を使用する。
- ・出力雑音電圧は平均値指示型実効値目盛 (VT VM) のピーク値を示す。ただし AC 電源は AC 1 次側ラインのフリッカ性ノイズの影響をなくするため AC 安定化電源 (50 Hz) を使用する。



外形図 4029
(unit: mm)



・これらの仕様は、改良などのため変更することがあります。

